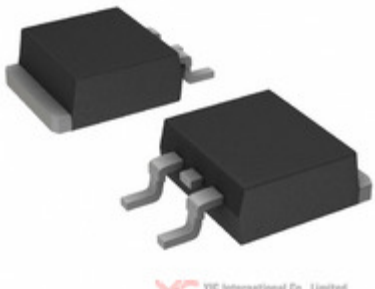

	<p>Hersteller-Teilenummer: NSB8JT3E3_A/P</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>
	<p>Datenblätter:  NSB8JT3E3_A/P.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	NSB8JT3E3_A/P
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	55pF @ 4V, 1MHz

NSB8JT3E3_A/P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSB8JT3E3_A/P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSB8JT3E3_A/P Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NSB8JT3E3_A/P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NSB8JT3E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8KT-E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8KT-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8JT3E3_A/P Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>
 <p>NSB8JT3E3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8JT3E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8KT-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8JT3E3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSB8JT3E3_A/P Vishay / Semiconductor - Diodes Division	NSB8JT3E3_A/P Datenblatt	NSB8JT3E3_A/P-Datenblätter	NSB8JT3E3_A/P PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division NSB8JT3E3_A/P
NSB8JT3E3_A/P Electronic	NSB8JT3E3_A/P-Komponenten	NSB8JT3E3_A/P-Verteiler	NSB8JT3E3_A/P-Bild	NSB8JT3E3_A/P-Teil
NSB8JT3E3_A/P Preis	NSB8JT3E3_A/P Hersteller	NSB8JT3E3_A/P Bild	NSB8JT3E3_A/P Aktie	NSB8JT3E3_A/P Inventar
NSB8JT3E3_A/P Neu	NSB8JT3E3_A/P Original	NSB8JT3E3_A/P garantiert	NSB8JT3E3_A/P RFQ	NSB8JT3E3_A/P Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited